



Benjamin BARDET

Docteur en sciences des matériaux - Chef de projets expérimenté

COMPÉTENCES

- **Connaissances en sciences des matériaux, électronique, électrochimie**
- 5 ans d'expériences en **management de projets de développement de produits**
- 3 ans d'expérience en **management de petite équipe technique** (2 à 4 personnes)
- Compétences en **analyse** et la **résolution de problèmes** (8D, AMDEC)
- **Anglais courant** pratiqué au quotidien

CENTRES D'INTÉRÊT

- Théâtre d'**improvisation** à la *Cie La Clef* et le **jeu de rôle entre amis**
- **Canicross** avec *Les Accropattes*
- **Psychologie** courant humaniste, bénévole écoutant à *SOS Amitié* (approche centrée sur la personne), **CNV**

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2017-2024	<p>Ingénieur Produits & Tests – Diodes de puissance en carbure de silicium (SiC) <i>STMicroelectronics, Tours (37), CDI</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Management de projets collaboratifs : développement de diodes de puissance en SiC, de la rédaction du cahier des charges à la mise en production. Animation des AMDEC (analyse de risques formalisée)• Management d'une équipe technique de 2 à 4 personnes. Référent technique en diodes SiC pour les usines de production en Italie / Chine et support ponctuel aux clients
2013-2017	<p>Ingénieur R&D – Electrochimie appliquée à l'optimisation de composants Radio-Fréquence <i>GREMAN, Tours (37), Doctorat de 3 ans en collaboration avec STMicroelectronics Tours</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Sujet de doctorat : Synthèse de substrats poreux fonctionnalisés pour optimiser des filtres utilisés dans les smartphones• Auteur ou co-auteur de 10 articles publiés dans des revues à comité de lecture• Collaborations multiples avec des entreprises et laboratoires en France et à l'étranger (Chine, Hongrie)
2013	<p>Stages cursus ingénieurs : R&D – STMicroelectronics, Tours (37), Stage ingénieur de 6 mois</p> <ul style="list-style-type: none">• Intégration et caractérisation d'inductances RF (0,1 – 20 GHz) intégrées sur un substrat poreux : réalisation de prototypes en salle blanche et caractérisation RF
2012	<p>R&D – LTM / CEA LETI, Grenoble (38), Stage ingénieur de 4 mois</p> <ul style="list-style-type: none">• Métrologie du contrôle dimensionnel de la largeur de grille de transistors 32 nm : mesures AFM et création d'un script d'analyse de données sous MATLAB
2011	<p>Qualité – Valco Group, Ruffec (16), Stage de 1 mois et CDD de 2 mois</p> <ul style="list-style-type: none">• Contrôle QA de vannes industrielles : analyse physico-chimique et contrôle de la traçabilité des matières premières, rédaction des PV de conformités.

FORMATIONS TECHNIQUES

2018-2024	<p>Formation continue : analyse transactionnelle en gestion de projets, écoute centrée sur la personne (IFRDP Cycle 1)</p>
2017	<p>Doctorat en électronique de l'Université François Rabelais de Tours, Mention Très honorable. <i>Soutenue le 10 mai 2017</i></p>
2013	<p>Diplôme d'Ingénieur Grenoble INP – Phelma, Mention Bien</p> <ul style="list-style-type: none">• Sciences et Ingénierie des Matériaux – Spécialisation en fonctionnalisation des matériaux pour l'électronique et les systèmes d'énergie
2008-2010	<p>Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (MPSI/MP) au Lycée Camille Guérin de Poitiers</p>